

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成17年11月24日(2005.11.24)

【公開番号】特開2002-20848(P2002-20848A)

【公開日】平成14年1月23日(2002.1.23)

【出願番号】特願2000-204927(P2000-204927)

【国際特許分類第7版】

C 2 2 F 1/10

C 2 2 C 14/00

C 2 2 F 1/18

// C 2 2 F 1/00

【F I】

C 2 2 F 1/10 G

C 2 2 C 14/00 Z

C 2 2 F 1/18 H

C 2 2 F 1/00 B

C 2 2 F 1/00 6 0 4

C 2 2 F 1/00 6 0 6

C 2 2 F 1/00 6 3 0 L

C 2 2 F 1/00 6 3 1 A

C 2 2 F 1/00 6 8 3

C 2 2 F 1/00 6 8 5 A

C 2 2 F 1/00 6 8 5 Z

C 2 2 F 1/00 6 9 1 B

C 2 2 F 1/00 6 9 1 C

【手続補正書】

【提出日】平成17年10月5日(2005.10.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】 形状記憶合金素材を結晶の大きさが実質的に均一な微細結晶構造とする工程により平均的結晶粒径を10ミクロン以下とする請求項1記載の形状記憶合金の処理方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項8】 異方性を持った微細で実質的に大きさが均一な結晶粒を生成する工程において、形状記憶合金素材を緩みのない無負荷状態で形状を拘束したまま、再結晶開始温度以上かつ再結晶開始温度付近の温度に短時間加熱する請求項3, 4, 5または6記載の形状記憶合金の処理方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項19

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 9】 平均的結晶粒径を 10 ミクロン以下とされた請求項 1 8 記載の形状記憶合金。